

КОЛЕБАНИЯ ТОКА В ДВУХДОЛИННЫХ ПОЛУПРОВОДНИКАХ ПРИ НАЛИЧИИ ВНЕШНЕГО ПОСТОЯННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ

Э.Р.ГАСАНОВ, Р.К.ГАСЫМОВА

*Бакинский Государственный Университет
AZ 1148, Баку, ул. З.Халилова 23*

Вычислены амплитуда колебания тока и частота колебания в двухдолинных полупроводниках типа *GaAs* во внешнем электрическом и магнитном поле. Найдены аналитические выражения для амплитуды тока и частота колебания в первом Боголюбовском приближении.

Колебания тока во внешнем электрическом поле в двухдолинных полупроводниках типа *GaAs* впервые изучены в работе [1] и на основе этого эксперимента созданы Ганновские приборы. Генерация (т.е. излучение энергии) энергии с определенной частотой есть основа приготовления Ганновских приборов. Эти приборы работают при определенном интервале внешнего электрического поля. Аналитические значения этих полей теоретически найдены (критические значения электрического поля) во многих работах и, в том числе, в работе [2]. В этой работе мы будем исследовать колебания тока в двухдолинных полупроводниках типа *GaAs* при наличии внешнего постоянного электрического E_0 и магнитного H_0 полей. Плотность тока в двухдолинных соединениях типа *GaAs* состоит из двух слагаемых

$$J = J_1 + J_2, \quad (1)$$

где J_1 - плотность тока носителей в первой долине, J_2 - плотность тока носителей во второй долине. Без внешних полей концентрации носителей тока в долинах $n_2 \ll n_1$, и поэтому плотность тока без внешних полей $J_2 \ll J_1$, тогда

$$\vec{J} = e\mu\vec{E} + en\mu_1[\vec{E}\vec{H}] + eD\nabla n + eD_1[\vec{\nabla}n\vec{H}]. \quad (2)$$

Мы будем рассматривать колебания тока в одномерном случае, и поэтому

$$\vec{H}_0 = |H_0|\vec{h} = H_{0z}\vec{h}; \quad \vec{E}_0 = |E_{0x}|\vec{i}.$$

Для значения магнитного поля [3] будем использовать формулы

$$\mu = \frac{\alpha\mu_0}{1 + \left(\frac{\mu_0 H_0}{c}\right)^2}, \quad \mu_1 = \frac{\sqrt{2}\mu_0 \frac{\mu_0 H_0}{c}}{1 + \left(\frac{\mu_0 H_0}{c}\right)^2}. \quad (3)$$

При классически сильном магнитном поле $\alpha \sim 1$

$$\mu = \alpha\mu_0 \left(\frac{H_{xar}}{H_0}\right)^2, \quad \mu_1 = \sqrt{2}\mu_0 \left(\frac{H_{xar}}{H_0}\right), \quad H_{xar} = \frac{c}{\mu_0}.$$

Обозначив $n = f(E)N(E)$, $N = N_0 + N_1$, $f = f_0 + f_1$, $E = E_0 + E_1$, из (2) получим

$$\begin{aligned} \vec{J}_1 = & \sigma_0 \alpha \left(\frac{H_{xar}}{H_0}\right)^2 \vec{E}_0 \left(f_0 \frac{E_1}{E_0} + f_0 \frac{N_1}{N_0} + f_0 \frac{N_1}{N_0} \frac{E_1}{E_0} + f_1 + f_1 \frac{E_1}{E_0} + f_1 \frac{N_1}{N_0} + \frac{f_1 N_1 E_1}{N_0 E_0} \right) + \\ & + \sigma_0 \sqrt{2} \frac{H_{xar}}{H_0} \vec{E}_0 \left\{ \frac{[\vec{E}_0 \vec{h}]}{E_0} + \frac{[\vec{E}_1 \vec{h}]}{E_0} \right\} + D_0 \alpha e N_0 \left(\frac{H_{xar}}{H_0}\right)^2 \frac{\partial}{\partial x} \left(f_0 \frac{N_1}{N_0} + f_1 + f_1 \frac{N_1}{N_0} \right) + \\ & + e \sqrt{2} D_0 \frac{H_{xar}}{H_0} N_0 \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(f_0 \frac{N_1}{N_0} + f_1 + f_1 \frac{N_1}{N_0} \right) \vec{h} \right] \end{aligned} \quad (4)$$

В (4) учтены все нелинейные слагаемые относительно N_1, f_1, E_1 . В одномерном случае уравнение непрерывности с учетом тока смещения имеет вид

$$J_1 = -\varepsilon \frac{\partial E_1}{\partial t}. \quad (5)$$

Учитывая значения электрического поля из уравнения Пуассона и обозначив $Y = \frac{N_1}{N_0}$ с учетом (4), получим следующее нелинейное уравнение относительно Y :

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 Y}{\partial t^2} + \frac{f_0 \sigma_0 k_x u_0 \alpha}{\varepsilon} \left(\frac{H_{xar}}{H_0} \right)^2 Y = \frac{\sigma_0 k_x u_0 \alpha}{\varepsilon} \left(\frac{H_{xar}}{H_0} \right)^2 & \left[-\frac{f_0}{k_x u_0} \frac{\partial Y}{\partial t} - \frac{f_0}{k_x u_0} Y \frac{\partial Y}{\partial t} + \right. \\ & \left. + \frac{f_0 - S_0}{k_x u_0} \frac{\partial Y}{\partial t} + \frac{f_0 - S_0}{k_x^2 u_0^2} \left(\frac{\partial Y}{\partial t} \right)^2 + \frac{f_0 - S_0}{k_x u_0} Y \frac{\partial Y}{\partial t} + \frac{f_0 - S_0}{k_x^2 u_0^2} Y \left(\frac{\partial Y}{\partial t} \right)^2 \right] + \\ & + \frac{\sqrt{2} \sigma_0 k_x u_0}{\varepsilon} \frac{H_{xar}}{H_0} \left(1 + \frac{1}{k_x u_0} \frac{\partial Y}{\partial t} \right) - \frac{\sigma_0 \alpha k_x^2 D_0}{\varepsilon} \left(\frac{H_{xar}}{H_0} \right)^2 \left[f_0 Y + \frac{S_0 - f_0}{k_x u_0} \frac{\partial Y}{\partial t} + \right. \\ & \left. + 2 \frac{S_0 - f_0}{k_x u_0} Y \frac{\partial Y}{\partial t} \right] + \frac{\sqrt{2} \sigma_0 k_x^2 D_0}{\varepsilon} \left(1 - \frac{L_x}{L_y} \right) \left[f_0 Y + \frac{S_0 - f_0}{k_x u_0} \frac{\partial Y}{\partial t} - \frac{2(S_0 - f_0)}{k_x u_0} Y \frac{\partial Y}{\partial t} \right] \end{aligned} \quad (6)$$

здесь $u_0 = \mu_0 E_0$, L_x и L_y соответствующие размеры кристалла, обозначив

$\tau = \omega_0 t$, $\omega_0^2 = \frac{f_0 \sigma_0 k_x u_0 \alpha}{\varepsilon} \left(\frac{H_{xar}}{H_0} \right)^2$, получим из (6) следующее нелинейное уравнение

относительно Y :

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 Y}{\partial \tau^2} + Y = r \left\{ \left[a + \frac{rza}{f_0} - \frac{\sqrt{2}}{\alpha f_0^2} \alpha \frac{H_0}{H_{xar}} + \frac{k_x^2 D_0}{f_0 k_x u_0} a - \frac{\sqrt{2} k_x D_0 \left(1 - \frac{L_x}{L_y} \right) z}{\alpha f_0^2 u_0} a \right] \sin \psi + \right. \\ & + \left[a^2 + \frac{rz}{f_0} a^2 + \frac{2z k_x^2 D_0}{f_0 k_x u_0} \alpha^2 + \frac{\sqrt{2} k_x D_0}{\alpha f_0^2 u_0} \left(1 - \frac{L_x}{L_y} \right) 2za^2 \right] \sin \psi \cos \psi - \\ & - \frac{zr^2}{f_0} a^2 \sin^2 \psi - \frac{zr^2}{f_0} a^3 \sin^2 \psi \cos \psi + \frac{\sqrt{2}}{\alpha f_0^2} \frac{H_0}{H_{xar}} \frac{1}{r} + \left[-\frac{k_x^2 D_0}{ru_0} \alpha + \frac{\sqrt{2} k_x D_0}{\alpha f_0^2 u_0} + \right. \\ & \left. + 2z \left(1 - \frac{L_x}{L_y} \right) a^2 \right] \cos \psi \right\} = r\Phi \end{aligned} \quad (7)$$

здесь $r = \frac{\omega_0}{k_x u_0}$ - малый параметр, при $r = 0$ решение уравнения (7)

$Y = a \cos \psi$, $\psi = \omega_0 t + \theta$, a - амплитуда, $z = f_0 - S_0$. Решение нелинейного уравнения (7) при значениях малого параметра $r \ll 1$ по методу Боголюбова - Митропольского [3] в первом приближении имеет вид:

$$\frac{da}{dt} = -\frac{\omega_0 r}{2\pi} \int_0^{2\pi} \Phi \left(Y, \frac{dY}{d\tau} \right) \sin \psi d\psi = -\frac{\omega_0 a}{2} \beta$$

$$\beta = 1 + \frac{rz}{f_0} - \frac{\sqrt{2}}{\alpha f_0^2} \frac{H_0}{H_{xar}} + \frac{k_x D_0}{f_0 u_0} + \frac{\sqrt{2} k_x D_0}{\alpha f_0^2 u_0} \left(\frac{L_x}{L_y} - 1 \right)$$

и
$$a = a_0 e^{-\frac{r\omega_0 \beta}{2} t} . \quad (8)$$

После несложного вычисления для β получим

$$\beta = \frac{k_x D_0 R}{\varphi u_0} \left[1 + \frac{\sqrt{2}}{\alpha} \frac{R}{\varphi} \left(\frac{L_x}{L_y} - 1 \right) \right] - \frac{r m x_0^m}{R} - \frac{\sqrt{2}}{\alpha} \left(\frac{R}{\varphi} \right)^2 \frac{H_0}{H_x} , \quad (9)$$

здесь $R = \varphi + x_0^m$; $\varphi = m - 1 > 1$, m - число которое определено в эксперименте [4] и может принимать значения 3,4,5.

Из (9) легко видно, что при значениях $L_x \leq L_y$, с ростом внешнего магнитного поля амплитуда a (8) растет, и этот случай соответствует генерации колебания.

Из (9) легко видно, что при

$$\frac{kD\sqrt{2}}{u_0\alpha} \left(\frac{R}{\varphi} \right)^2 \frac{L_x}{L_y} = \frac{r m x_0^m}{R} \quad (10)$$

амплитуда колебания a с ростом внешнего магнитного поля H_0 увеличивается, и этот случай соответствует значению электрического поля

$$\frac{E_0}{E_a} = \left(\frac{E_0}{E_\varphi} \right)^{1/2m} , \quad \frac{1}{E_\varphi^{1/2}} = \frac{m(m-1)}{3} \frac{L_y}{L_x} \frac{H_x}{H_0} \left(\frac{\alpha f_0 \sigma_0 \mu_0}{\epsilon k^3 D_0^2} \right)^{1/2} . \quad (11)$$

Из (11) видно, что с ростом внешнего магнитного поля H_0 увеличивается E_φ и уменьшается значение электрического поля E_0 , при котором происходит излучение, т.е. колебания тока. Таким образом, во внешнем магнитном поле можно уменьшить критическое электрическое поле, соответствующее генерации энергии. Частоты колебания в первом приближении находим:

$$\frac{d\psi}{dt} = \omega_0 \left[1 - \frac{\omega_0}{2\pi k u_0 a} \int_0^{2\pi} \Phi \left(Y, \frac{dY}{d\tau} \right) \cos \psi d\psi \right] = \omega_1 = \omega_0 \left[1 - \frac{1}{8} \left(\frac{\omega_0 a}{k u_0} \right)^2 \right] . \quad (12)$$

Из (12) легко видно, что частота колебания в первом приближении уменьшается.

1. Дж.Ганн, Новые методы полупроводниковой СВЧ-электроники, изд. Мир, (1968) 51,
2. E.R.Qasanov, R.K.Qasimova, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutu, Fizika, XI №1 (2005) в печати.
3. Б.И.Давыдов, ЖЭТФ,7 (1937) 1069.
4. Н.Н.Боголюбов, Ю.А.Митропольски, Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний, Москва, (1963) 36.
5. Р.Энгельман, К.Куэйт, Новые методы полупроводниковой СВЧ- электроники, издательство, Мир, (1968) 51.

XARİCİ MAGNİT SAHƏSİ OLDUGDA İKİDƏRƏLİ YARIMKEÇİRİCİLƏRDƏ CƏRƏYAN RƏGSLƏRİ

E.R.HƏSƏNOV, R.K.GASIMOVA

Xarici elektrik və maqnit sahəsində yerləşən iki dərəli *GaAs* tipli yarımkeçiricilərdə yaranan cərəyan rəqslərinin amplitudu və tezliyi hesablanmışdır. Tezlik və amplitudun analitik ifadələri tapılmışdır.

E.R.GASANOV, R.K.GASIMOV

The amplitude of fluctuation of a current and frequency of fluctuation in two-valley semiconductors of type *GaAs* in external electric and magnetic field have been calculated. Analytical expressions for amplitude of a current and frequency of fluctuation in the first Bogolyubov's approximation have been found.

Редактор: Б.Аскеров